

(19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 特許公報 (B2)

(11) 特許番号

特許第3077941号  
(P3077941)

(45) 発行日 平成12年8月21日 (2000.8.21)

(24) 登録日 平成12年6月16日 (2000.6.16)

(51) Int.Cl.  
G 0 1 T 1/20

識別記号

F I  
G 0 1 T 1/20

B

請求項の数10(全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平10-535567  
 (86) (22) 出願日 平成10年2月12日 (1998.2.12)  
 (86) 国際出願番号 PCT/JP98/00551  
 (87) 国際公開番号 WO98/36291  
 (87) 国際公開日 平成10年8月20日 (1998.8.20)  
 審査請求日 平成10年11月30日 (1998.11.30)  
 (31) 優先権主張番号 特願平9-30510  
 (32) 優先日 平成9年2月14日 (1997.2.14)  
 (33) 優先権主張国 日本 (JP)

(73) 特許権者 99999999  
 浜松ホトニクス株式会社  
 静岡県浜松市市野町1126番地の1  
 本目 阜也  
 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松  
 ホトニクス株式会社内  
 高林 敏雄  
 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松  
 ホトニクス株式会社内  
 佐藤 宏人  
 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松  
 ホトニクス株式会社内  
 (74) 代理人 99999999  
 弁理士 長谷川 芳樹 (外2名)  
 審査官 長井 真一

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 放射線検出素子及びその製造方法

1

## (57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】複数の受光素子を基板上に1次元あるいは2次元に配列して受光部を形成し、前記受光部の各行又は各列の前記受光素子と電気的に接続された複数のボンディングパッドを前記受光部の外部に配置した受光素子アレイと、前記受光部の少なくとも有効画面領域の前記受光素子上に堆積された放射線を可視光に変換するシンチレータ層と、前記受光素子アレイ上の前記シンチレータ層が形成された領域と前記ボンディングパットの配置された領域を区分する閉じた枠状に形成された樹脂からなる一つあるいは複数の樹脂枠と、少なくとも前記シンチレータ層を覆うとともに、前記樹脂枠上まで達して少なくとも前記ボンディングパッド部

10

2

を露出させている放射線透過性の耐湿保護膜と、を備えている放射線検出素子。

【請求項2】前記樹脂枠は、前記有効画面領域を囲む略矩形形状に形成されていることを特徴とする請求項1記載の放射線検出素子。

【請求項3】前記一つあるいは複数の樹脂枠は、各々前記ボンディングパット部領域を囲む略矩形上に形成されていることを特徴とする請求項1又は2のいずれかに記載の放射線検出素子。

【請求項4】前記樹脂枠に沿って前記耐湿保護膜の縁を覆う被覆樹脂をさらに備えている請求項1～3のいずれかに記載の放射線検出素子。

【請求項5】前記耐湿保護層は、少なくとも有機膜を含む2層以上の多層膜からなることを特徴とする請求項1～4のいずれかに記載の放射線検出素子。

【請求項6】前記耐湿保護膜は、少なくとも一層の無機膜を含むことを特徴とする請求項5記載の放射線検出素子。

【請求項7】複数の受光素子を基板上に1次元あるいは2次元に配列して受光部を形成し、前記受光部の各行又は各列の前記受光素子と電気的に接続された複数のボンディングパッドを前記受光部の外部に配置した受光素子アレイの前記受光部の少なくとも有効画面領域の前記受光素子上に放射線を可視光に変換するシンチレータ層を堆積させる工程と、

前記受光素子アレイ上に樹脂により前記シンチレータ層と前記ボンディングパッド部を区分する一つあるいは複数の閉じた枠状の樹脂枠を形成する工程と、

前記受光素子アレイ全体を包み込む放射線透過性の耐湿保護膜を形成する工程と、

前記樹脂枠の長手方向に沿って、前記耐湿保護膜を切断し、ボンディングパット部上の前記耐湿保護膜を除去して前記ボンディングパッド部を露出させる工程と、

を有する放射線検出素子の製造方法。

【請求項8】切断した前記耐湿保護膜の縁を前記樹脂枠に沿って樹脂により覆って接着する工程をさらに備える請求項7記載の放射線検出素子の製造方法。

【請求項9】前記耐湿保護膜を形成する工程は、放射線透過性の第1の有機膜を形成する工程と、前記第1の有機膜上に少なくとも1層以上の膜をさらに積層して、2層以上の多層膜からなる放射線透過性の耐湿保護膜を形成する工程と、

からなることを特徴とする請求項7または8のいずれかに記載の放射線検出素子の製造方法。

【請求項10】前記耐湿保護膜は、少なくとも1層の無機膜を含むことを特徴とする請求項9記載の放射線検出素子の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 技術分野

本発明は、放射線検出素子、特に、医療用のX線撮影等に用いられる大面積の受光部を有する放射線検出素子に関する。

##### 背景技術

医療、工業用のX線撮影では、従来、X線感光フィルムが用いられてきたが、利便性や撮影結果の保存性の面から放射線検出素子を用いた放射線イメージングシステムが普及してきている。このような放射線イメージングシステムにおいては、複数の画素を有する放射線検出素子を用いて放射線による2次元画像データを電気信号として取得し、この信号を処理装置により処理して、モニタ上に表示している。代表的な放射線検出素子は、1次元あるいは2次元に配列された光検出器上にシンチレータを配して、入射する放射線をシンチレータで光に変換して、検出する仕組みになっている。

典型的なシンチレータ材料であるCs Iは、吸湿性材料

であり、空気中の水蒸気（湿気）を吸収して溶解する。この結果、シンチレータの特性、特に解像度が劣化するという問題があった。

シンチレータを湿気から保護する構造とした放射線検出素子としては、特開平5-196742号公報に開示された技術が知られている。この技術では、シンチレータ層の上部に水分不透過性の防湿パリヤを形成することにより、シンチレータを湿気から保護している。

##### 発明の開示

10 しかし、この技術では、シンチレータ層外周部の防湿パリヤを放射線検出素子の基板に密着させることが難しく、特に、胸部X線撮影などに用いる大面積の放射線検出素子においては、外周部の長さが長いため、防湿パリヤがはがれやすくなってしまって、シンチレータ層が完全に密封されず、水分がシンチレータ層に侵入してその特性が劣化しやすいという欠点がある。

また、この技術では、防湿パリヤの水分シール層は、シリコーンポッティング材等を液状の状態でシンチレータ層に塗工するか、放射線検出素子の受光面側に設置する窓材の内側にこのシリコーンポッティング材等を塗工した後、水分シール層の乾燥前にこの窓材をシンチレータ層上に設置することにより、水分シール層を固定する製造方法が開示されている。この製造方法では、水分シール層を表面形状が不規則なシンチレータ層上に均一に形成することが難しく、密着性が低下する可能性がある。この点は、特に、大面積の放射線検出素子で起こりやすい。

30 本発明は、上記の問題点に鑑みてシンチレータの防湿用に均一で製造が容易な保護膜を有する放射線検出素子及びその製造方法を提供することを課題とするものである。

この課題を解決するために、本発明の放射線検出素子は、(1)複数の受光素子を基板上に1次元あるいは2次元に配列して受光部を形成し、この受光部の各行又は各列の受光素子と電気的に接続された複数のボンディングパッドを受光部の外部に配置した受光素子アレイと、

40 (2)受光部の受光素子上に堆積された放射線を可視光に変換するシンチレータ層と、(3)受光素子アレイ上のシンチレータ層が形成された領域とボンディングパットの配置された領域を区分する閉じた枠状に形成された樹脂からなる一つあるいは複数の樹脂枠と、(4)少なくともシンチレータ層を覆うとともに、樹脂枠上まで達して少なくともボンディングパッド部を露出させている放射線透過性の耐湿保護膜と、を備えていることを特徴とする。

これにより、入射した放射線は、シンチレータ層で可視光に変換される。この可視光像を1次元あるいは2次元に配列された受光素子により検出することで、入射する放射線像に対応する画像電気信号が得られる。シンチレータ層は吸湿によって劣化する性質を有するが、本発

明によれば、シンチレータ層は耐湿保護膜によって覆われており、この耐湿保護膜は樹脂枠によって受光素子アレイに密着しているので、シンチレータ層は完全に密封されて外気から隔離され、空気中の水蒸気から保護されている。さらに、外部回路との接続用のボンディングパッド部は、露出されている。

この樹脂枠は、シンチレータ層を囲む矩形形状か一つあるいは複数のボンディングパッド領域をそれぞれ囲む矩形形状に形成することが好ましい。

また、樹脂枠に沿って耐湿保護膜の縁を覆う被覆樹脂をさらに備えていてもよい。これにより、耐湿保護膜の縁は、樹脂枠と被覆樹脂によって上下から挟まれ、強固に接着される。

一方、本発明の放射線検出素子の製造方法は、(1)複数の受光素子を基板上に1次元あるいは2次元に配列して受光部を形成し、この受光部の各行又は各列の受光素子と電気的に接続された複数のボンディングパッドを受光部の外部に配置した受光素子アレイの受光部の受光素子上に放射線を可視光に変換するシンチレータ層を堆積させる工程と、(2)受光素子アレイ上に樹脂によりシンチレータ層とボンディングパッド部を区分する一つあるいは複数の閉じた枠状の樹脂枠を形成する工程と、(3)受光素子アレイ全体を包み込む放射線透過性の耐湿保護膜を形成する工程と、(4)樹脂枠の長手方向に沿って、耐湿保護膜を切断し、ボンディングパット部上の耐湿保護膜を除去してボンディングパッド部を露出させる工程と、を有することを特徴とする。

受光素子アレイ全体を包みこむように耐湿保護膜を形成することで、シンチレータ層と耐湿保護膜の密着度が向上し、均一な膜が形成される。耐湿保護膜を形成してから、ボンディングパッド部分の保護膜を取り除くことにより、ボンディングパッド部が確実に露出される。保護膜の下に形成された樹脂枠により、保護膜切断時のカッターの切り込み深さに余裕が生ずる。さらに、樹脂枠により、保護膜の縁が基板に密着され、封止が確実になる。

さらに、切断した耐湿保護膜の縁を樹脂枠に沿って樹脂により覆って接着する工程をさらに備えていてもよい。これにより、耐湿保護膜の縁は、樹脂枠とこの樹脂に挟み込まれて強固に接着される。

本発明は以下の詳細な説明および添付図面によりさらに十分に理解可能となる。これらは単に例示のために示されるものであって、本発明を限定するものと考えるべきではない。

本発明のさらなる応用範囲は、以下の詳細な説明から明らかになるだろう。しかしながら、詳細な説明および特定の事例は本発明の好適な実施形態を示すものではあるが、例示のためにのみ示されているものであって、本発明の思想および範囲における様々な変形および改良はこの詳細な説明から当業者には明らかであることははっ

きりしている。

#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明の一実施形態の上面図であり、図2は、そのA-A線拡大断面図である。

図3～図11は、図1および図2に係る実施形態の製造工程を示す図である。

図12は、本発明の別の実施形態の上面図であり、図13は、そのB-B線拡大断面図である。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。なお、理解を容易にするために各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の参照番号を附し、重複する説明は省略する。また、各図面における寸法、形状は実際のものとは必ずしも同一ではなく、理解を容易にするため誇張している部分がある。

図1は、本発明の一実施形態の上面図であり、図2はその外周辺部のA-A線拡大断面図である。

まず、図1、図2を参照して本実施形態の構成を説明する。絶縁性、例えばガラス製の基板1上に、光電変換を行なう受光素子2が2次元上に配列されて、受光部を形成している。この受光素子2は、アモルファスシリコン製のフォトダイオード(PD)や薄膜トランジスタ(TFT)から構成されている。各行又は各列の受光素子2の各々は、信号読み出し用の信号線3により電気的に接続されている。外部回路(図示していない)へ信号を取り出すための複数のボンディングパッド4は、基板1の外周辺、例えば隣接する2辺、に沿って配置されており、信号線3を介して対応する複数の受光素子2に電気的に接続されている。受光素子2及び信号線3上には、絶縁性のパッシベーション膜5が形成されている。このパッシベーション膜5には、窒化シリコン、又は酸化シリコンを用いることが好ましい。一方、ボンディングパッド4は、外部回路との接続のために露出されている。以下、この基板及び基板上の回路部分を受光素子アレイ6と呼ぶ。

受光素子アレイ6の受光部上には、入射した放射線を可視光に変換する柱状構造のシンチレータ7が形成されている。シンチレータ7には、各種の材料を用いることができるが、発光効率が良いTlドープのCsIが好ましい。また、受光素子アレイ6の受光部の外周を囲み、ボンディングパッドの内側位置には、細長い枠状に形成された樹脂製の樹脂枠8が配置されている。この樹脂枠8には、シリコン樹脂である信越化学製のKJR651あるいはKE4897、東芝シリコン製TSE397、住友3M製DYMAX625T等を用いることが好ましい。これらは、半導体素子の機械的、電気的保護のための表面処理用に広く用いられており、後述する上部に形成される保護膜12との密着性も高いからである。

樹脂枠8の枠内のシンチレータ7上には、いずれもX線を透過し、水蒸気を遮断する第1の有機膜9と、無機

膜10と、第2の有機膜11とがそれぞれ積層されて保護膜12を形成している。

第1の有機膜9と第2の有機膜11には、ポリパラキシリレン樹脂（スリーボンド社製、商品名パリレン）、特にポリパラクロロキシリレン（同社製、商品名パリレンC）を用いることが好ましい。パリレンによるコーティング膜は、水蒸気及びガスの透過が極めて少なく、撥水性、耐薬品性も高いほか、薄膜でも優れた電気絶縁性を有し、放射線、可視光線に対して透明であるなど有機膜9、11にふさわしい優れた特徴を有している。パリレンによるコーティングの詳細については、スリーボンド・テクニカルニュース（平成4年9月23日発行）に記されており、ここでは、その特徴を述べる。

パリレンは、金属の真空蒸着と同様に真空中で支持体の上に蒸着する化学的蒸着（CVD）法によってコーティングすることができる。これは、原料となるP-キシリレンを熱分解して、生成物をトリエン、ベンゼンなどの有機溶媒中で急冷しダイマーと呼ばれるジパラキシリレンを得る工程と、このダイマーを熱分解して、安定したラジカルパラキシリレンガスを生成させる工程と、発生したガスを素材上に吸着、重合させて分子量約50万のポリパラキシリレン膜を重合形成させる工程からなる。

パリレン蒸着時の圧力は、金属真空蒸着の場合の圧力0.001トールに比べて高い0.1～0.2トールである。そして、蒸着時には、単分子膜が被着物全体を覆った後、その上にパリレンが蒸着していく。したがって、0.2μm厚さからの薄膜をピンホールのない状態で均一な厚さに生成することができ、液状では不可能だった鋭角部やエッジ部、ミクロンオーダの狭い隙間へのコーティングも可能である。また、コーティング時に熱処理等を必要とせず、室温に近い温度でのコーティングが可能なため、硬化に伴う機械的応力や熱歪みが発生せず、コーティングの安定性にも優れている。さらに、ほとんどの固体材料へのコーティングが可能である。

また、無機膜10にはX線透過性であれば、可視光に対しては、透明、不透明、反射性などの各種の材料を用いることができ、Si、Ti、Crの酸化膜や金、銀、アルミニなどの金属薄膜が使用できる。特に、可視光に対して反射性の膜を用いると、シンチレータ7で発生した蛍光が外に漏れるのを防ぎ感度を上昇させる効果があるので好ましい。ここでは、成形が容易なAlを用いた例について説明する。Al自体は空気中で腐蝕しやすいが、無機膜10は、第1の有機膜9及び第2の有機膜11で挟まれているため、腐蝕から守られている。

この保護膜12は、前述したパリレンコーティングによって形成されるが、CVD法によって形成されるため、受光素子アレイ6の表面全体を覆うように形成される。そのため、ボンディングパッド4を露出させるためには、ボンディングパッド4より内側でパリレンコーティングで形成された保護膜12を切断して、外部の保護膜12を除

去する必要がある。後述するように、樹脂枠8の枠部分の略中心付近で保護膜12を切断することにより、保護膜12の外周部は樹脂枠8によって固定されるので、保護膜12が外周部からはがれるのを防止することができる。さらに、この保護膜12の外周部は、被覆樹脂13によってその下の樹脂枠8とともにコーティングされている。被覆樹脂13には、保護膜12及び樹脂枠8への接着性が良好な樹脂、例えばアクリル系接着剤である協立化学産業株式会社製WORLD ROCK No.801-SET2 (70,000cPタイプ) を用いることが好ましい。この樹脂接着剤は、100mW/cm<sup>2</sup>の紫外線照射により約20秒で硬化し、硬化皮膜は柔軟かつ十分な強度を有し、耐湿、耐水、耐電触性、耐マイグレーション性に優れており、各種材料、特にガラス、プラスチック等への接着性が良好で、被覆樹脂13として好ましい特性を有する。あるいは、樹脂枠8と同じシリコン樹脂を用いてもよい。または、樹脂枠8にこの被覆樹脂13とおなじアクリル系接着剤を用いてもよい。

次に、図3～図11を参照して、この実施形態の製造工程について説明する。図3に示されるような受光素子アレイ6の受光面上に図4に示されるように、T1をドープしたCs Iの柱状結晶を蒸着法によって600μmの厚さだけ成長させてシンチレータ7層を形成する。

一方、図5に示されるように受光部と受光素子アレイのそれぞれの外周の間で、ボンディングパッド4の内側のパッシバーション膜5上に受光部の外辺に沿って樹脂枠8が幅1mm、高さ0.6mmの細長い枠状に形成される。この枠形成には、例えば、岩下エンジニアリング製AutoShooter-3型のような自動X-Yコーティング装置を用いるといい。この時に、上部に形成される第1の有機膜9との密着性をさらに向上させるため、樹脂枠8の表面を粗面処理すればより好ましい。粗面処理としては、筋をいれたり、表面に多数の小さなくぼみを形成する処理がある。

シンチレータ7層を形成するCs Iは、吸湿性が高く、露出したままにしておくと空気中の水蒸気を吸湿して溶解してしまう。そこで、これを防止するために、図6に示されるように、CVD法により厚さ10μmのパリレンで基板全体を包み込んで第1の有機膜9を形成する。Cs Iの柱状結晶には隙間があるが、パリレンはこの狭い隙間にある程度入り込むので、第1の有機膜9は、シンチレータ層に密着する。さらに、パリレンコーティングにより、凹凸のあるシンチレータ7層表面に均一な厚さの精密薄膜コーティングが得られる。また、パリレンのCVD形成は、前述したように、金属蒸着時よりも低真空で、かつ常温で行うことができるため、加工が容易である。

さらに、図7に示されるように、入射面側の第1の有機膜9表面に0.2μm厚さのAl膜を蒸着法により積層して無機膜10を形成する。そして、再度CVD法により、パリレンを基板全体の表面に10μm厚さで被覆して第2の有機膜11を形成する（図8参照）。この第2の有機膜11

には、無機膜10の腐蝕による劣化を防ぐ。

こうして形成した保護膜12を樹脂枠8の長手方向に沿ってカッター14で切断する(図9参照)。樹脂枠8で凸部が形成されているため、切断箇所の確認が容易なほか、樹脂枠8の厚みの分だけカッター14を挿入する際の余裕があるため、樹脂枠8の下にある信号線3を傷つけるおそれがなくなり、加工が簡単になり、製品の歩留まりが向上する。そして、この切断部から外側及び入射面裏側の保護膜12を除去して、外部回路との接続用のボンディングパッド4を露出させる(図10参照)。その後、保護膜12の外周部と露出した樹脂枠8を覆うようにアクリル樹脂からなる被覆樹脂13でコーティングして紫外線照射により、被覆樹脂13を硬化させる(図11参照)。

ここで、一般にパッシベーション膜5と第1の有機膜9は、密着性が悪い。しかし、本実施形態の構造によれば、第1の有機膜9とパッシベーション膜5との間に双方と密着する樹脂枠8を介しているため、第1の有機膜9が樹脂枠8によりパッシベーション膜5に密着する。また、被覆樹脂13を設けなくとも、保護膜12は、樹脂枠8を介して受光素子アレイ12に密着するが、被覆樹脂13を形成すれば、第1の有機膜9を含む保護膜12が樹脂枠8と被覆樹脂13に挟み込まれて固定されるので、受光素子アレイ6上への保護膜12の密着性がより一層向上して好ましい。したがって、保護膜12によりシンチレータ7が密封されるので、シンチレータ7への水分の侵入を確実に防ぐことができ、シンチレータ7の吸湿劣化による素子の解像度低下を防ぐことができる。

統いて、本実施形態の動作を図1、図2により、説明する。入射面側から入射したX線(放射線)は、第1の有機膜9、無機膜10、第2の有機膜11の全てを透過してシンチレータ7に達する。このX線は、シンチレータ7で吸収され、X線の光量に比例した可視光が放射される。放射された可視光のうち、X線の入射方向に逆行した可視光は、第2の有機膜11を透過して、無機膜10で反射される。このため、シンチレータ7で発生した可視光はほとんど全てが、パッシベーション膜5を経て受光素子2に入射する。このため、効率の良い検出が可能となる。

各々の受光素子2では、光電変換により、この可視光の光量に対応する電気信号が生成されて一定時間蓄積される。この可視光の光量は入射するX線の光量に対応しているから、つまり、各々の受光素子2に蓄積されている電気信号は、入射するX線の光量に対応することになり、X線画像に対応する画像信号が得られる。受光素子2に蓄積されたこの画像信号を信号線3を介してボンディングパッド4から順次読み出すことにより、外部に転送し、これを所定の処理回路で処理することにより、X線像を表示することができる。

以上の説明では、保護膜12としてパリレン製の第1の有機膜9、11の間に無機膜10を挟み込んだ構造のものに

ついて説明したが、第1の有機膜9と第2の有機膜11の材料は異なるものでも良い。また、無機膜10として腐蝕に強い材料を使用しているような場合は、第2の有機膜11自体を設けなくてもよい。

また、ここでは、樹脂枠8と被覆樹脂13が受光素子アレイ6の受光素子2部分の外側のパッシベーション膜5上に形成されている例を説明したが、受光素子2とボンディングパッド4が近接している場合には、その境界部分に樹脂枠8を形成するのは困難である。ボンディングパッド4を確実に露出させ、かつ保護膜12の周囲を被覆樹脂13で確実にコーティングするためには、樹脂枠8および被覆樹脂13の位置を受光素子2側にずらすことが好みしい。そのためには、シンチレータ7を受光素子2上の全面に形成するのではなく、ボンディングパッド4近傍の画素を除いた有効画面領域の受光素子2上に形成する。そして、有効画面領域の外側、つまり無効画素上に樹脂枠8を形成した上で、形成したシンチレータ7の層全部を覆い、樹脂枠8に達するように保護膜12を形成する。その後、樹脂枠8の長手方向に沿って保護膜12を切断し、有効画面領域外の保護膜12を除去し、樹脂枠8に沿って保護膜12の縁を被覆樹脂13によりコーティングすればよい。この場合、ボンディングパッド4近傍の画素は樹脂枠8と被覆樹脂13で覆われるか、前面にシンチレータ7が存在しないので、その放射線に対する感度が低下し、結果としてこれらの画素は使用できず受光素子2の有効画素数、有効画面面積が減少することとなるが、受光素子2が大画面で全画素数が多い場合には、無効画素の比率は少なく、素子の構成によっては製作が容易になるメリットがある。

次に、図12、図13を参照して本発明の別の実施形態について説明する。図12はこの実施形態の放射線検出素子の上面図であり、図13はそのB-B線拡大断面図である。この素子の基本的な構成は、図1および図2に示される実施形態の素子と同一であり、相違点のみを以下、説明する。

図12、図13に示されるこの実施形態では、保護膜12は受光素子アレイ6の受光面側および裏面側の前面に形成されており、ボンディングアレイ4部分のみが露出されている。そして、露出されたボンディングアレイ4部分を囲むように、樹脂枠8が形成されており、この樹脂枠8上で保護膜12の境界(縁)に沿って被覆樹脂13がコーティングされている。本実施形態でも、ボンディングパッド4部が確実に露出されるとともに、保護膜12は樹脂枠8と被覆樹脂13により受光素子アレイ6に確実に密着されるのでシンチレータ7層が密封されて、吸湿による劣化を防止することができる。

これは特にボンディングパッド4部が小さいCCDやMOS型の撮像素子の場合に保護膜のはがれを引き起こすおそれのある境界部分である縁部分の長さを減らすことができ有効である。

さらに、以上の説明では、受光素子上のシンチレータ側から放射線を入射させるいわゆる表面入射型の放射線検出素子について説明してきたが、本発明は、基板側から放射線を入射させるいわゆる裏面入射型の放射線検出素子への適用も可能である。こうした裏面入射型の放射線検出素子は、高エネルギーの放射線検出素子として用いることができる。

以上、説明したように、本発明によれば、吸湿製の高いシンチレータを保護するために、シンチレータ上にパリレン等からなる保護膜が形成されており、この保護膜の外周は樹脂層により受光素子アレイに接着されているので、シンチレータ層が密封される。特に、保護膜の縁からののはがれが防止されているので、耐湿性が向上する。

さらに、この縁を被覆樹脂で覆えば、密封性がより一層向上して、耐湿性が増す。

本発明の製造方法によれば、保護膜を形成後不要部分を除去するので、必要部分のみに保護膜を形成する場合

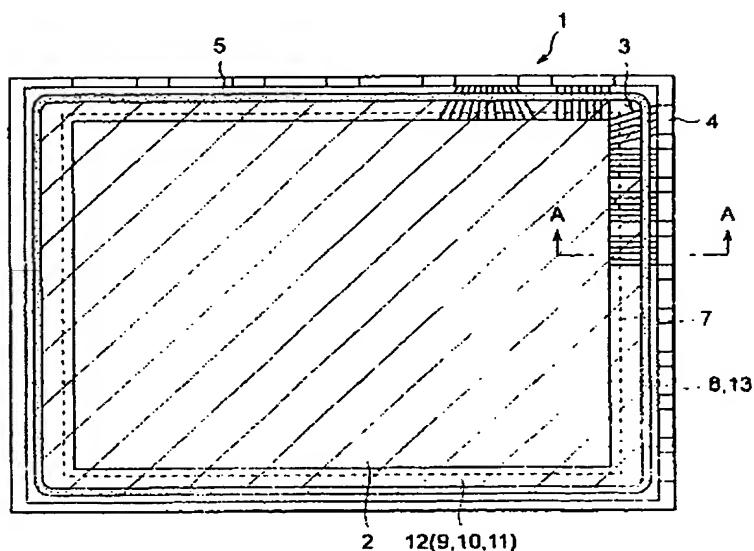
に比べて均一な状態の保護膜形成が容易であり、ボンディングパッドが確実に露出される。また、シンチレータ層の柱状結晶の隙間に保護膜が浸透するので保護膜とシンチレータ層の密着性が増す。また、切断時に樹脂層の厚さだけカッターの切り込み余裕があるので、切断工具の精度を上げなくとも検出信号を読み出す信号線を傷つけることがなく、製品の歩留まりが向上する。

以上の本発明の説明から、本発明を様々な変形しうることは明らかである。そのような変形は、本発明の思想および範囲から逸脱するものとは認めることはできず、すべての当業者にとって自明である改良は、以下の請求項の範囲に含まれるものである。

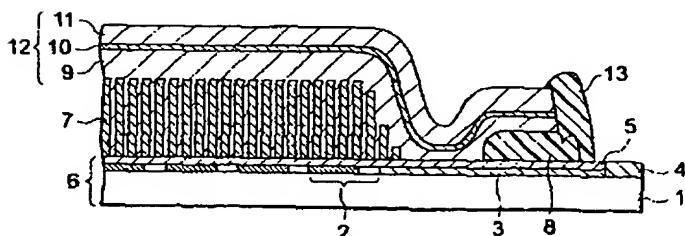
#### 産業上の利用可能性

本発明の放射線検出素子は、特に医療、工業用のX線撮影で用いられる大面積の放射線イメージングシステムに適用可能である。特に、現在広く用いられているX線フィルムに代えて胸部X線撮影等に使用することができる。

【第1図】

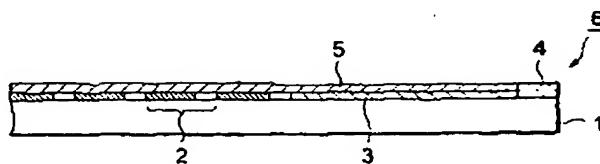


【第2図】

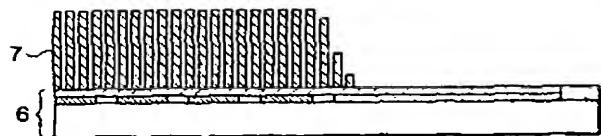


A-A線断面図

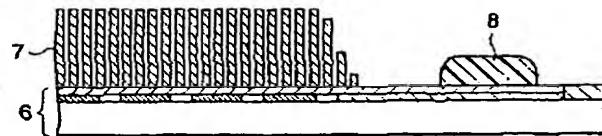
【第3図】



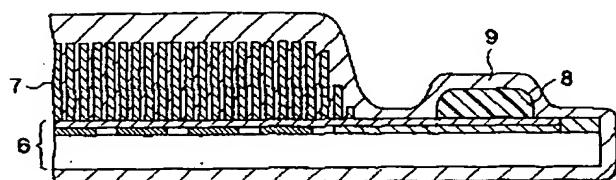
【第4図】



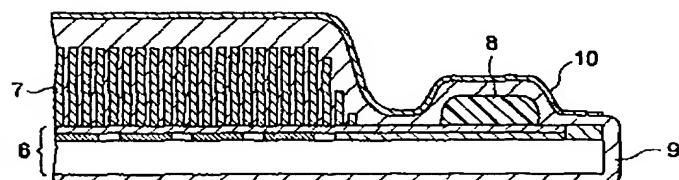
【第5図】



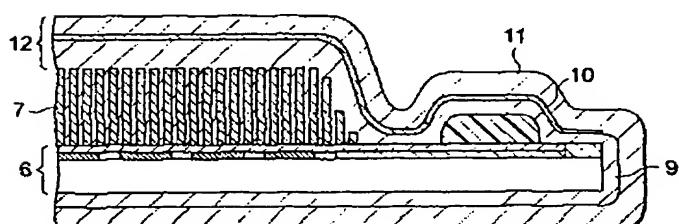
【第6図】



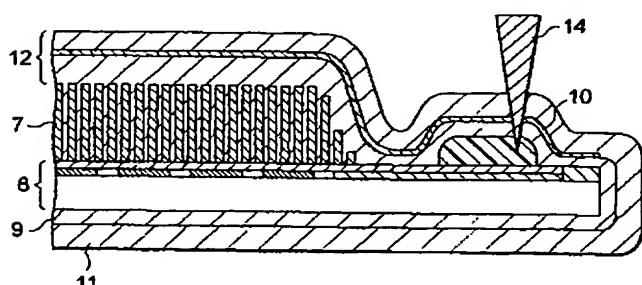
【第7図】



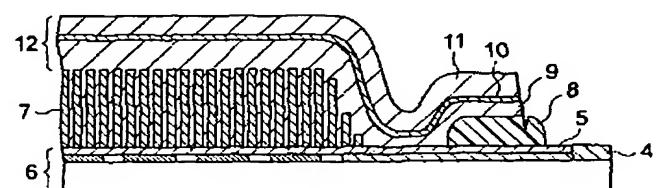
【第8図】



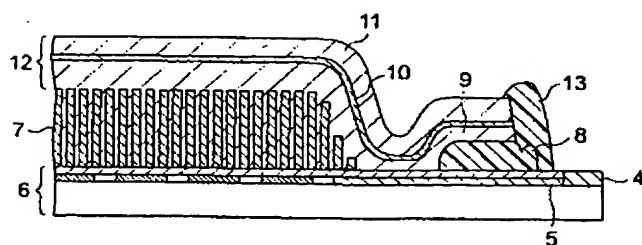
【第9図】



【第10図】

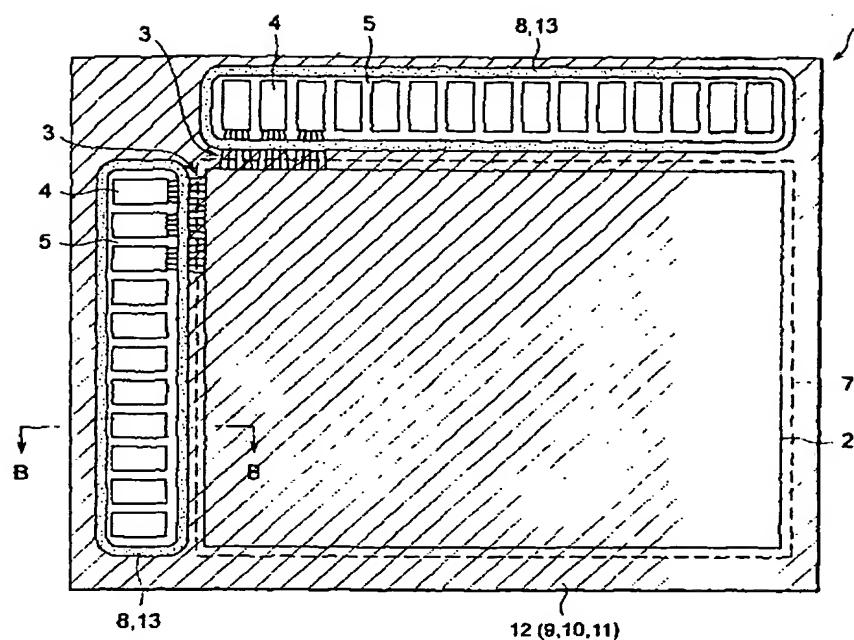


【第11図】

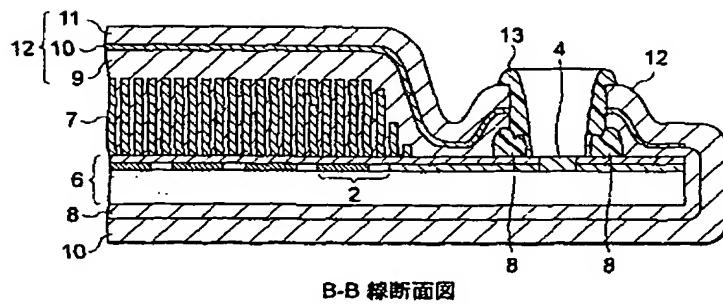


BEST AVAILABLE COPY

【第12図】



【第13図】



フロントページの続き

## (56)参考文献

特開 平9-257943 (J P, A)  
 特開 平9-152486 (J P, A)  
 特開 平9-45952 (J P, A)  
 特開 平5-60871 (J P, A)  
 特開 平2-151789 (J P, A)  
 特開 昭63-215987 (J P, A)  
 米国特許5227635 (U S, A)

## (58)調査した分野(Int.C1.7, DB名)

G01T 1/20